

XHP™3 Modul mit Trench/Feldstopp IGBT3 und Emitter Controlled 3 Diode

Eigenschaften

- Elektrische Eigenschaften
 - $V_{CES} = 3300\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 450\text{ A} / I_{CRM} = 900\text{ A}$
 - Große DC-Festigkeit
 - Hohe Kurzschlussrobustheit
 - Niedrige Schaltverluste
 - Niedriges V_{CEsat}
 - $T_{vj\text{ op}} = 150^{\circ}\text{C}$
 - Sehr große Robustheit
- Mechanische Eigenschaften
 - ALSiC Bodenplatte für erhöhte thermische Lastwechselfestigkeit
 - Isolierte Bodenplatte
 - Gehäuse mit CTI > 600
 - Gehäuse mit erweiterten Isolationseigenschaften von 10,4kV AC 60s



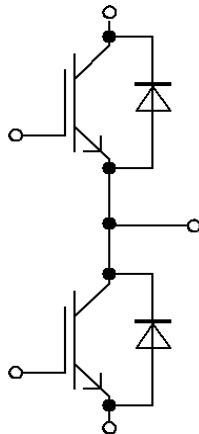
Potenzielle Anwendungen

- Traktionsumrichter
- Mittelspannungsantriebe
- Motorantriebe

Produktvalidierung

- Qualifiziert für Industrieanwendungen entsprechend den relevanten Tests der IEC 60747, 60749 und 60068

Beschreibung



Inhalt

	Beschreibung	1
	Eigenschaften	1
	Potenzielle Anwendungen	1
	Produktvalidierung	1
	Inhalt	2
1	Gehäuse	3
2	IGBT, Wechselrichter	3
3	Diode, Wechselrichter	5
4	Kennlinien	7
5	Schaltplan	11
6	Gehäuseabmessungen	12
7	Modul-Label-Code	13
	Änderungshistorie	14
	Disclaimer	15

1 Gehäuse

Tabelle 1 Isolationskoordination

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Isolations-Prüfspannung	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $t = 60 \text{ s}$	10.4	kV
Teilentladungs-Aussetzspannung	V_{isol}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$, $Q_{PD} \text{ typ. } 10 \text{ pC}$	5.1	kV
Material Modulgrundplatte			AlSiC	
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kühlkörper	53.0	mm
Kriechstrecke	d_{Creep}	Kontakt - Kontakt	53.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kühlkörper	36.0	mm
Luftstrecke	d_{Clear}	Kontakt - Kontakt	26.0	mm
Vergleichszahl der Kriechwegbildung	CTI		> 600	

Tabelle 2 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Modulstreuinduktivität	L_{SCE}			25		nH
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{AA'+CC'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		0.31		mΩ
Modulleitungswiderstand, Anschlüsse - Chip	$R_{CC'+EE'}$	$T_C = 25^\circ\text{C}$, pro Schalter		0.41		mΩ
Lagertemperatur	T_{stg}		-40		150	°C
Anzugsdrehmoment f. Modulmontage	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift M6, Schraube	4.25		5.75	Nm
Anzugsdrehmoment f. elektr. Anschlüsse	M	- Montage gem. gültiger Applikationsschrift M3, Schraube	0.9		1.1	Nm
		M8, Schraube	8		10	
Gewicht	G			700		g

2 IGBT, Wechselrichter

Tabelle 3 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte	Einh.
Kollektor-Emitter-Sperrspannung	V_{CES}		$T_{vj} = -40^\circ\text{C}$	3300	V
			$T_{vj} = 150^\circ\text{C}$	3300	
Kollektor-Dauergleichstrom	I_{CDC}	$T_{vj \text{ max}} = 150^\circ\text{C}$	$T_C = 100^\circ\text{C}$	450	A
Periodischer Kollektor-Spitzenstrom	I_{CRM}	t_p begrenzt durch $T_{vj \text{ op}}$		900	A

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 3 (Fortsetzung) Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Gate-Emitter-Spitzenspannung	V_{GES}		± 20	V

Tabelle 4 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Kollektor-Emitter-Sättigungsspannung	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 450\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	2.50	2.75	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	2.90		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	3.00	3.30	
Gate-Schwellenspannung	V_{GEth}	$I_C = 12\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$	5.20	5.80	6.40	V
Gateladung	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CE} = 1800\ V$		12.5		μC
Interner Gatewiderstand	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.3		Ω
Eingangskapazität	C_{ies}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$		84		nF
Rückwirkungskapazität	C_{res}	$f = 1000\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$		2		nF
Kollektor-Emitter-Reststrom	I_{CES}	$V_{CE} = 3300\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5	mA
Gate-Emitter-Reststrom	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$			400	nA
Einschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{don}	$I_C = 450\ A, V_{CE} = 1800\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.530		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.570		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	0.580		
Anstiegszeit (induktive Last)	t_r	$I_C = 450\ A, V_{CE} = 1800\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.100		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.130		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	0.130		
Abschaltverzögerungszeit (ind. Last)	t_{doff}	$I_C = 450\ A, V_{CE} = 1800\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	1.710		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	1.860		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	1.920		
Fallzeit (induktive Last)	t_f	$I_C = 450\ A, V_{CE} = 1800\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 3.3\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.130		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	0.240		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	0.270		
Einschaltzeit (ohmsche Last)	t_{on_R}	$I_C = 500\ A, V_{CE} = 2000\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.7\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	1.15		μs
Einschaltverlustenergie pro Puls	E_{on}	$I_C = 450\ A, V_{CE} = 1800\ V, L_\sigma = 85\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.7\ \Omega, di/dt = 3650\ A/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	500		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$	765		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$	845		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 4 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Abschaltverlustenergie pro Puls	E_{off}	$I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $L_\sigma = 85\text{ nH}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R_{Goff} = 3.3\ \Omega$, $dv/dt = 2850\text{ V}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	415		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	610		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	670		
Kurzschlussverhalten	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15\text{ V}$, $V_{CC} = 2500\text{ V}$, $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{sCE} \cdot di/dt$	$t_p \leq 10\ \mu\text{s}$, $T_{vj} \leq 150\text{ °C}$	1800		A
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro IGBT			28.4	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro IGBT, $\lambda_{paste} = 1\text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		17.4		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	°C

3 Diode, Wechselrichter

Tabelle 5 Höchstzulässige Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte	Einh.
Periodische Spitzensperrspannung	V_{RRM}	$T_{vj} = -40\text{ °C}$	3300	V
		$T_{vj} = 150\text{ °C}$	3300	
Dauergleichstrom	I_F		450	A
Periodischer Spitzenstrom	I_{FRM}	$t_p = 1\text{ ms}$	900	A
Grenzlastintegral	I^2t	$t_p = 10\text{ ms}$, $V_R = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ °C}$	kA ² s
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	
Spitzenverlustleistung	P_{RQM}	$T_{vj} = 150\text{ °C}$	1000	kW
Mindesteinschaltdauer	t_{onmin}		10	μs

Tabelle 6 Charakteristische Werte

Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung	Werte			Einh.
			Min.	Typ.	Max.	
Durchlassspannung	V_F	$I_F = 450\text{ A}$, $V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	3.10	3.50	V
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	2.75		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	2.65	2.95	
Rückstromspitze	I_{RM}	$V_R = 1800\text{ V}$, $I_F = 450\text{ A}$, $V_{GE} = -15\text{ V}$, $-di_F/dt = 3650\text{ A}/\mu\text{s}$ ($T_{vj} = 150\text{ °C}$)	$T_{vj} = 25\text{ °C}$	680		A
			$T_{vj} = 125\text{ °C}$	680		
			$T_{vj} = 150\text{ °C}$	680		

(wird fortgesetzt...)

Tabelle 6 (Fortsetzung) Charakteristische Werte

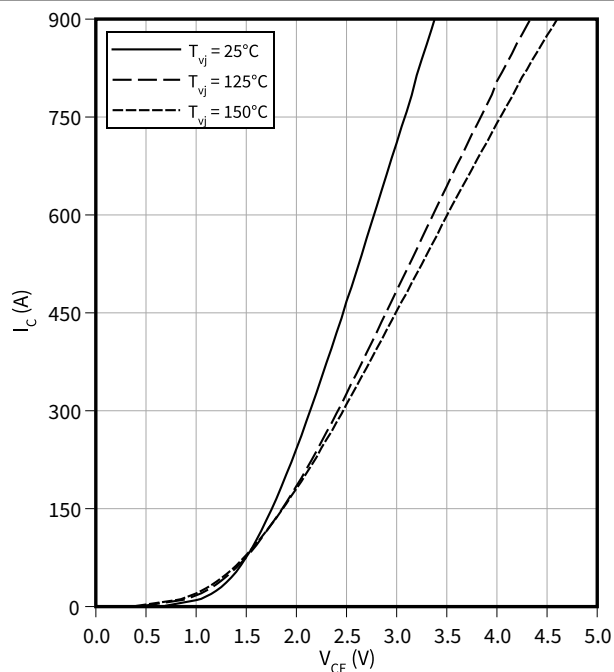
Parameter	Symbol	Notiz oder Prüfbedingung		Werte			Einh.
				Min.	Typ.	Max.	
Sperrverzögerungsladung	Q_r	$V_R = 1800 \text{ V}, I_F = 450 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 3650 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ °C})$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		230		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$		445		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$		525		
Abschaltenergie pro Puls	E_{rec}	$V_R = 1800 \text{ V}, I_F = 450 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 3650 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ °C})$	$T_{vj} = 25 \text{ °C}$		220		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ °C}$		490		
			$T_{vj} = 150 \text{ °C}$		595		
Wärmewiderstand, Chip bis Gehäuse	R_{thJC}	pro Diode				45.5	K/kW
Wärmewiderstand, Gehäuse bis Kühlkörper	R_{thCH}	pro Diode, $\lambda_{paste} = 1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$			19.3		K/kW
Temperatur im Schaltbetrieb	$T_{vj op}$			-40		150	°C

4 Kennlinien

Ausgangskennlinie (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

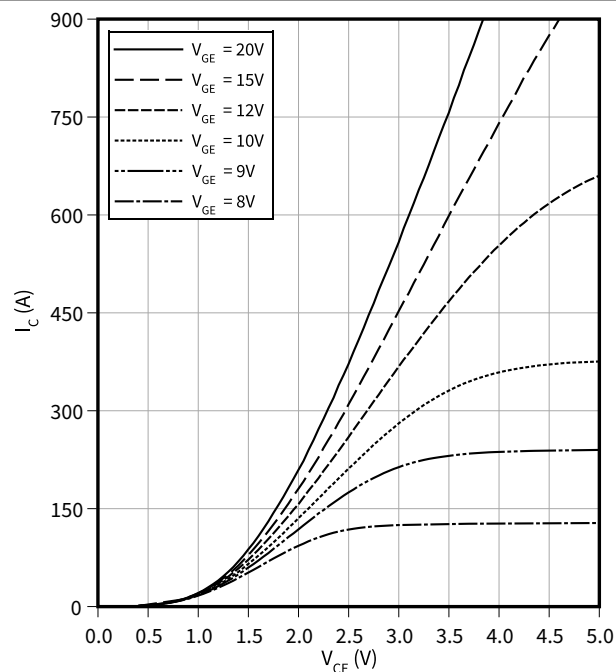
$$V_{GE} = 15 \text{ V}$$



Ausgangskennlinienfeld (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

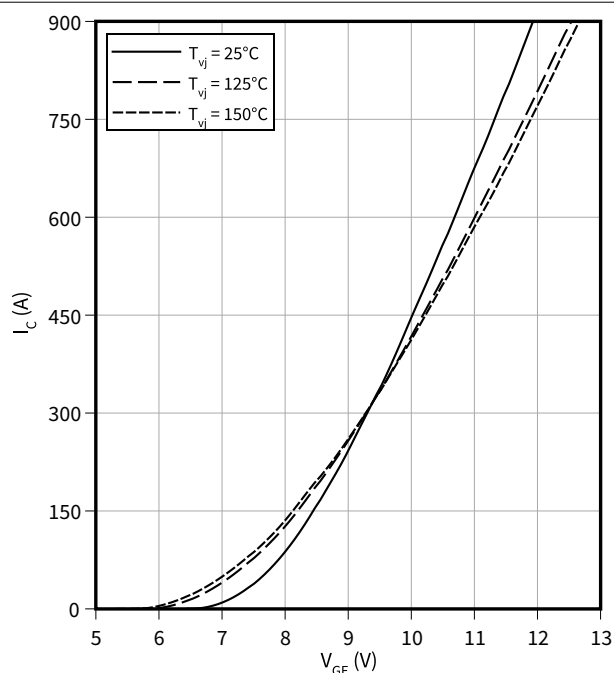
$$T_{vj} = 150 \text{ °C}$$



Übertragungscharakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{GE})$$

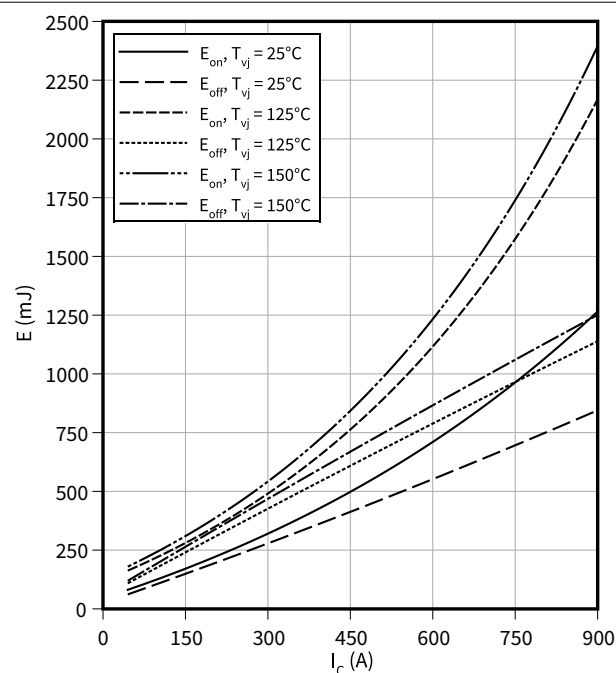
$$V_{CE} = 20 \text{ V}$$



Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$E = f(I_C)$$

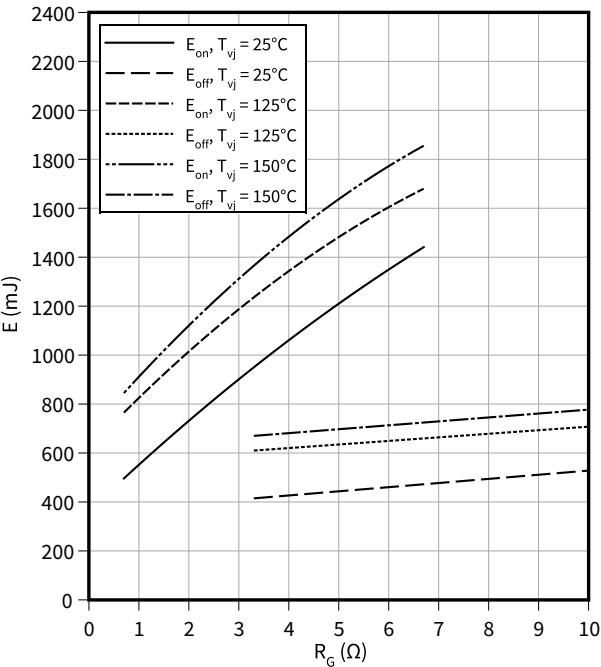
$$R_{Goff} = 3.3 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.7 \text{ } \Omega, V_{CE} = 1800 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$$



4 Kennlinien

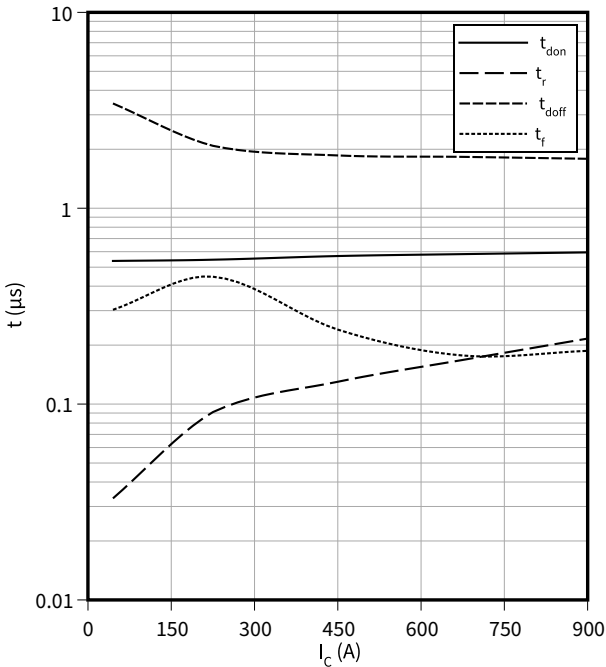
Schaltverluste (typisch), IGBT, Wechselrichter

$E = f(R_G)$
 $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$



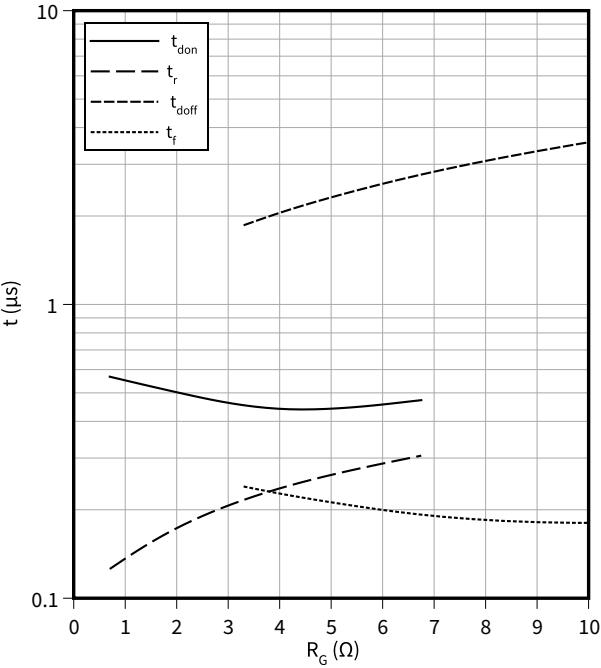
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(I_C)$
 $R_{Goff} = 3.3\text{ }\Omega$, $R_{Gon} = 0.7\text{ }\Omega$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$



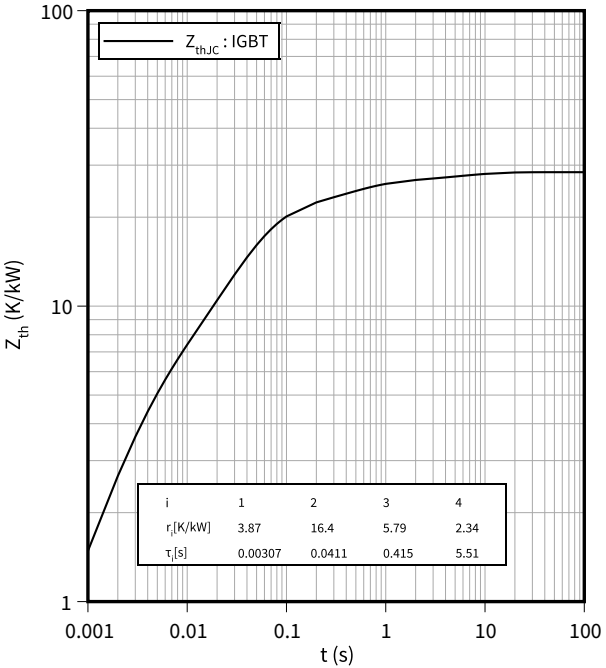
Schaltzeiten (typisch), IGBT, Wechselrichter

$t = f(R_G)$
 $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 1800\text{ V}$, $V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$



Transienter Wärmewiderstand , IGBT, Wechselrichter

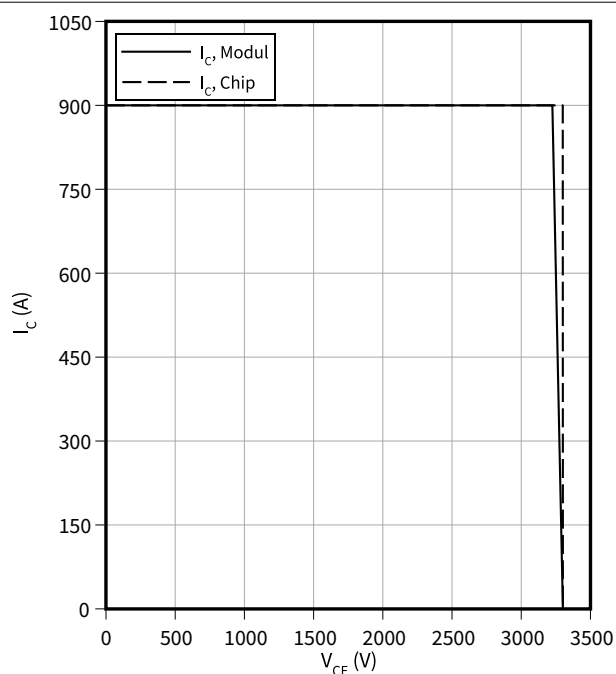
$Z_{th} = f(t)$



Sicherer Rückwärts-Arbeitsbereich (RBSOA), IGBT, Wechselrichter

$$I_C = f(V_{CE})$$

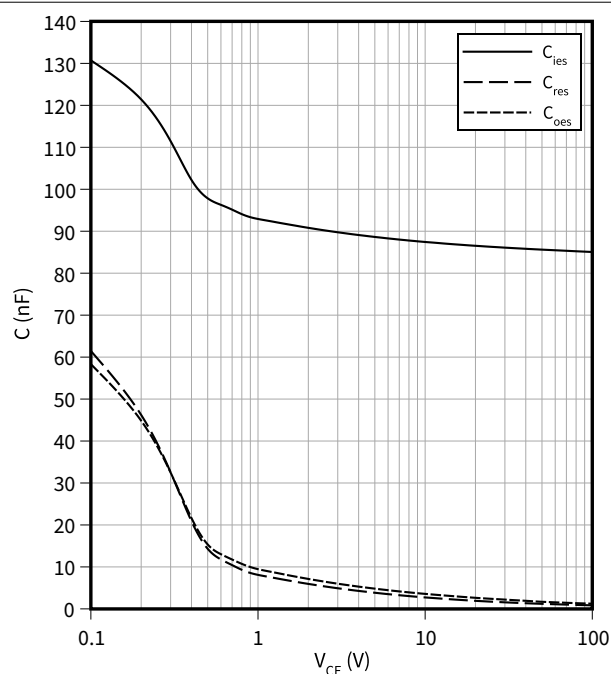
$R_{Goff} = 3.3 \Omega$, $V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$, $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$



Kapazitäts Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

$$C = f(V_{CE})$$

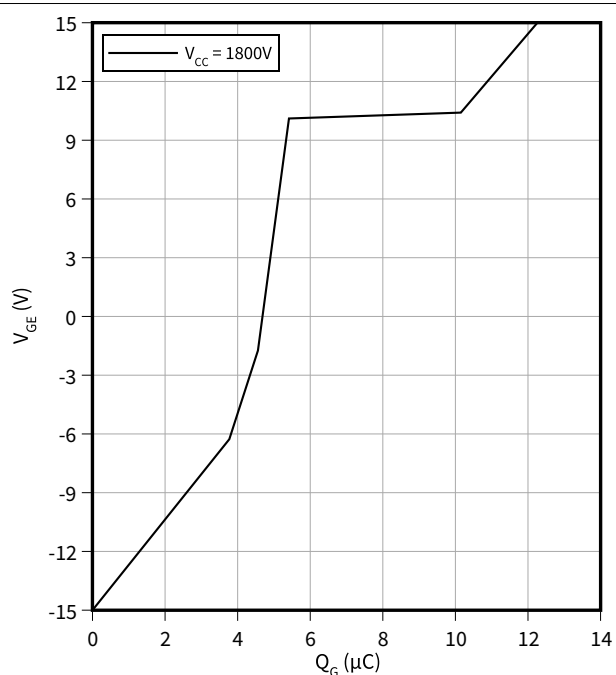
$f = 1000 \text{ kHz}$, $V_{GE} = 0 \text{ V}$, $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



Gateladungs Charakteristik (typisch), IGBT, Wechselrichter

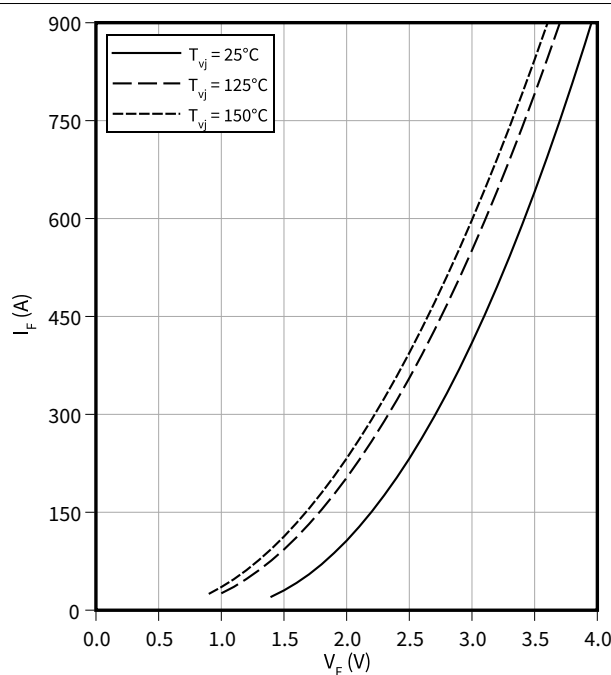
$$V_{GE} = f(Q_G)$$

$I_C = 450 \text{ A}$, $T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



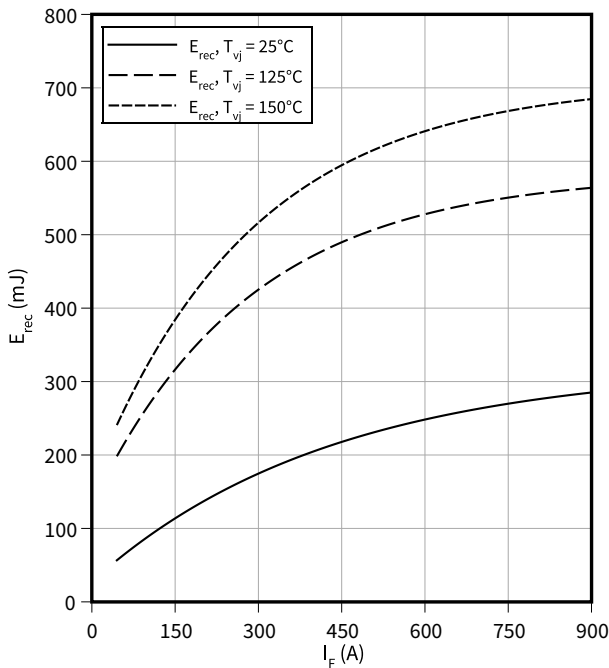
Durchlasskennlinie (typisch), Diode, Wechselrichter

$$I_F = f(V_F)$$



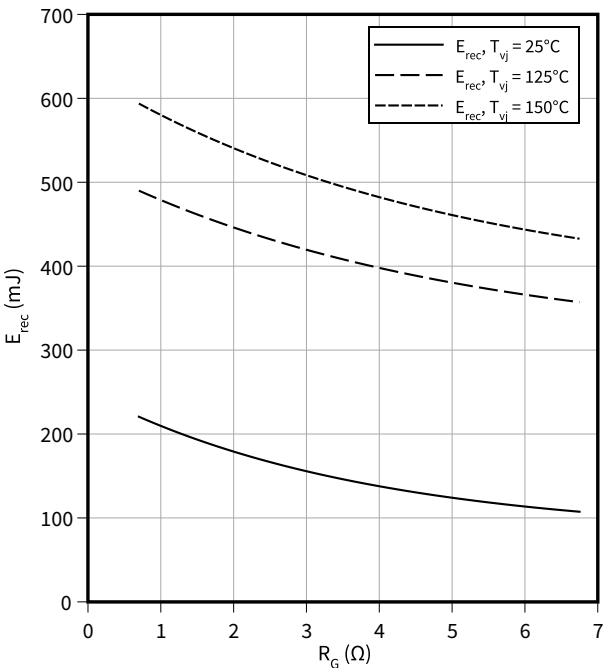
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(I_F)$
 $V_{CE} = 1800\text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$



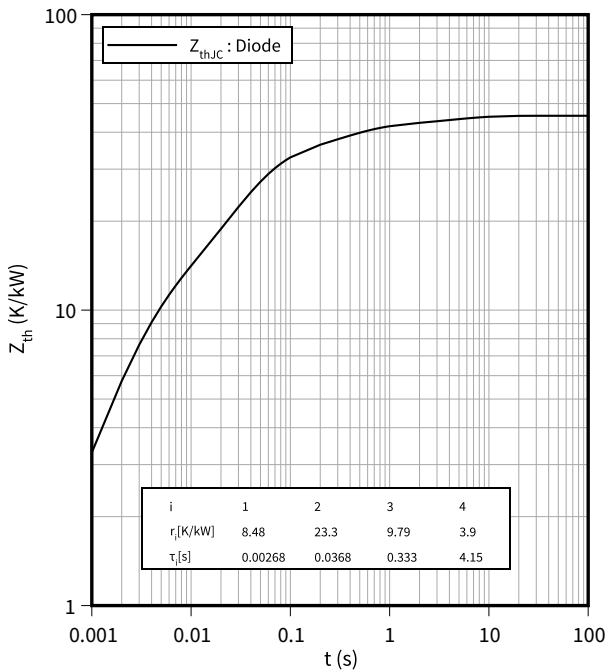
Schaltverluste (typisch), Diode, Wechselrichter

$E_{rec} = f(R_G)$
 $V_{CE} = 1800\text{ V}, I_F = 450\text{ A}$



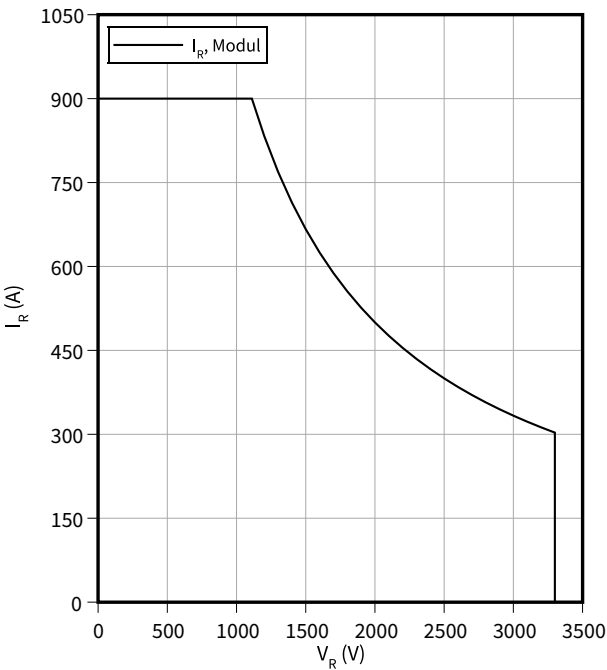
Transienter Wärmewiderstand, Diode, Wechselrichter

$Z_{th} = f(t)$



Sicherer Arbeitsbereich (SOA), Diode, Wechselrichter

$I_R = f(V_R)$
 $T_{vj} = 150\text{ °C}$



5 Schaltplan

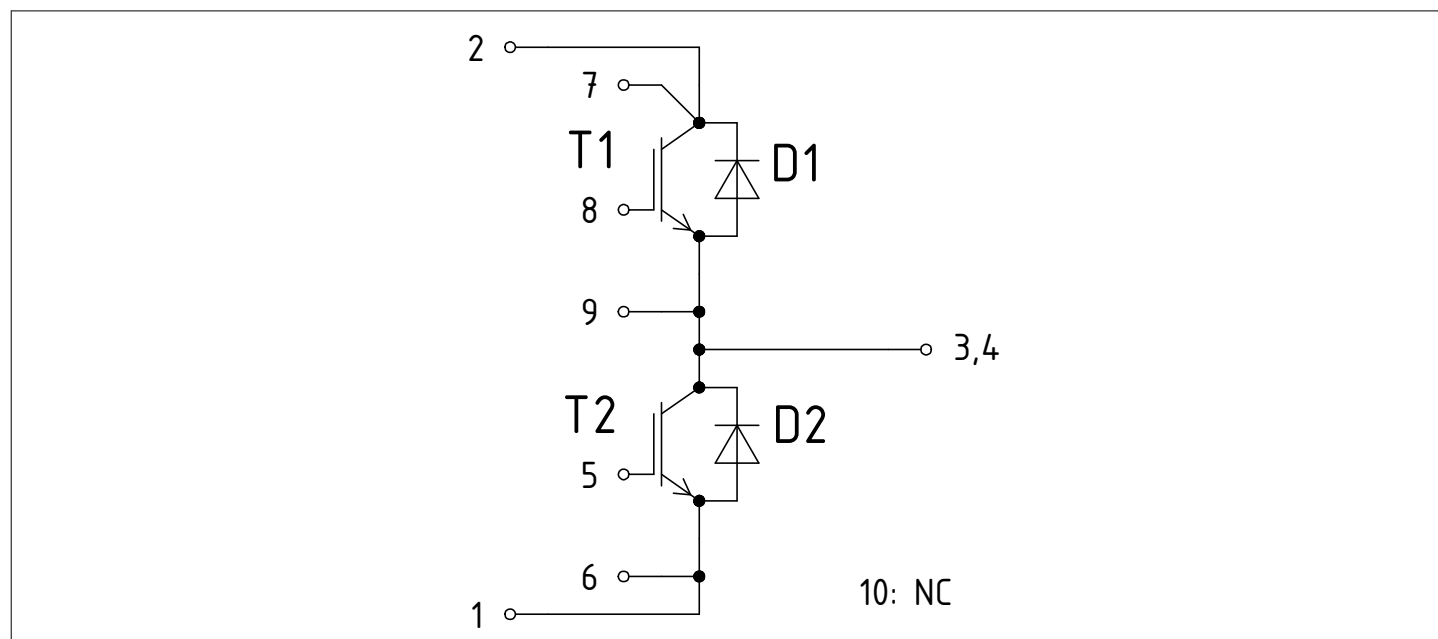


Abbildung 1

7 Modul-Label-Code

Module label code			
Code format	Data Matrix		Barcode Code128
Encoding	ASCII text		Code Set A
Symbol size	16x16		23 digits
Standard	IEC24720 and IEC16022		IEC8859-1
Code content	Content	Digit	Example
	Module serial number	1 – 5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 – 21	15
	Date code (production week)	22 – 23	30
Example	 71549142846550549911530  71549142846550549911530		

Abbildung 3

Änderungshistorie

Dokumentenrevision	Freigabedatum	Beschreibung der Änderungen
V2.0	2018-10-08	Preliminary datasheet
V3.0	2019-01-28	Final datasheet
V3.1	2020-01-27	Final datasheet
n/a	2020-09-01	Datasheet migrated to a new system with a new layout and new revision number schema: target or preliminary datasheet = 0.xy; final datasheet = 1.xy
1.10	2021-11-04	Final datasheet
1.20	2022-04-06	Final datasheet

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2022-04-06

Published by

Infineon Technologies AG
81726 Munich, Germany

© 2022 Infineon Technologies AG
All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference
IFX-AAY096-005

WICHTIGER HINWEIS

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keinesfalls Garantien für die Beschaffenheit oder Eigenschaften des Produktes ("Beschaffenheitsgarantie") dar.

Für Beispiele, Hinweise oder typische Werte, die in diesem Dokument enthalten sind, und/oder Angaben, die sich auf die Anwendung des Produktes beziehen, ist jegliche Gewährleistung und Haftung von Infineon Technologies ausgeschlossen, einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, die Gewähr dafür, dass kein geistiges Eigentum Dritter verletzt ist.

Des Weiteren stehen sämtliche, in diesem Dokument enthaltenen Informationen, unter dem Vorbehalt der Einhaltung der in diesem Dokument festgelegten Verpflichtungen des Kunden sowie aller im Hinblick auf das Produkt des Kunden sowie die Nutzung des Infineon Produktes in den Anwendungen des Kunden anwendbaren gesetzlichen Anforderungen, Normen und Standards durch den Kunden.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten sind ausschließlich für technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die Beurteilung der Eignung dieses Produktes für die beabsichtigte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Produktdaten für diese Anwendung obliegt den technischen Fachabteilungen des Kunden.

WARNHINWEIS

Aufgrund der technischen Anforderungen können Produkte gesundheitsgefährdende Substanzen enthalten. Bei Fragen zu den in diesem Produkt enthaltenen Substanzen, setzen Sie sich bitte mit dem nächsten Vertriebsbüro von Infineon Technologies in Verbindung.

Sofern Infineon Technologies nicht ausdrücklich in einem schriftlichen, von vertretungsberechtigten Infineon Mitarbeitern unterzeichneten Dokument zugestimmt hat, dürfen Produkte von Infineon Technologies nicht in Anwendungen eingesetzt werden, in welchen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass ein Fehler des Produktes oder die Folgen der Nutzung des Produktes zu Personenverletzungen führen.